

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0210U000860

Державний реєстраційний номер: 0108U002363

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 06-04-2010

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка та теоретичне і експериментальне дослідження нових високоефективних люмінесцентних наноструктур на основі кремнію і германію

Початок етапу: 04.2008

Закінчення етапу: 12.2008

Вид звітного документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 525-40-20

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594, 380442343243

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 190
--

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка та теоретичне і експериментальне дослідження нових високоефективних люмінесцентних наноструктур на основі кремнію і германію

Назва роботи англійською:

Development theoretical and experiment investigation of new high-efficient luminescent Si- and Ge-based nanostructures

Реферат українською:

Встановлено зв'язок між умовами формування фотолюмінесцентних оксидних плівок з Si, Ge квантовими точками при їх імпульсному лазерному осадженні та структурними властивостями таких плівок.

Проаналізовано вплив структури плівок на їх випромінювальні властивості в видимій області спектра при кімнатній температурі.

Реферат англійською:

Relationship between technological conditions of formation of oxide photoluminescent films with Si (Ge) quantum dots at their pulse laser deposition and structural properties of such film has been established. Analysis of the influence of film structure on the film luminescent properties at room temperatures in the visible range of spectrum has been fulfilled.

Індекс УДК: 535;539.183/.184;681.7;77, 621.315.592;535.37

Коди тематичних рубрик: 29.31

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Корбутяк Дмитро Васильович

Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Мачулін Володимир Федорович

Перелік осіб-виконавців

Єрмаков В.М.

Іваськевич Л.М.

Бегун Є.В.

Демчина Л.А.

Каганович Е.Б.

Калитчук С.М.

Корбутяк Д.В.

Крюченко Ю.В.

Купчак І.М.

Манойлов Е.Г.

Саченко А.В.

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

